

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

19.10.2004

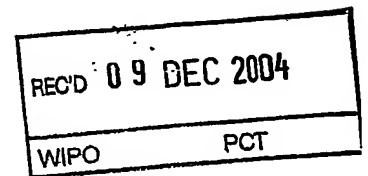
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 0 月 1 4 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 3 5 3 9 6 2
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 3 5 3 9 6 2]

出 願 人 コマツ電子金属株式会社
Applicant(s):



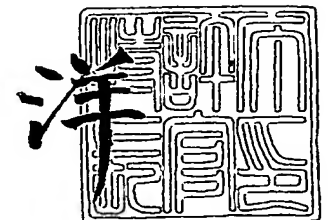
PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

2 0 0 4 年 1 1 月 2 5 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 AP030021
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 C30B 15/30
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県平塚市四之宮三丁目 2 5 番 1 号 コマツ電子金属株式会
 社内
 【氏名】 梅木 俊郎
【特許出願人】
 【識別番号】 000184713
 【氏名又は名称】 コマツ電子金属株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100115897
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 田中 秀晴
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 129633
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0104686

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

炉内に融液が充填されるルツボを設けたチャンバと、該ルツボを加熱するヒータと、前記チャンバ内に設けられたワイヤーとを備えた半導体単結晶製造装置において、

前記ワイヤーの少なくとも高温にさらされる領域を、カラーで覆ったことを特徴とする半導体単結晶製造装置。

【請求項 2】

前記カラーを複数に設けたことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体単結晶製造装置。

【請求項 3】

前記カラーはワイヤー巻き上げ装置と種結晶との間に設けられていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の半導体単結晶製造装置。

【請求項 4】

前記カラーを前記ワイヤーを覆うよう近接させて設けたことを特徴とする請求項 1～3 の何れか 1 つに記載の半導体単結晶製造装置。

【請求項 5】

炉内に融液が充填されるルツボを設けたチャンバと該チャンバの上方に配置されたブルチャンバと、該ブルチャンバの内部と前記チャンバとの間で昇降するシードホルダと、該シードホルダを連結部材を介して吊持するワイヤーとを備えた半導体単結晶製造装置において、

前記シードホルダ若しくは前記連結部材の少なくとも一方の長さを、前記シードホルダに種結晶を取り付け、該種結晶が融液に着液する位置にあるとき、前記ワイヤーの先端近傍の露出部分が前記炉内の高温雰囲気下で所定温度未満の範囲に位置する長さとしたことを特徴とする半導体単結晶製造装置。

【請求項 6】

前記所定温度未満とは 700℃未満であることを特徴とする請求項 5 に記載の半導体単結晶製造装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】半導体単結晶製造装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体インゴット（例えば、単結晶シリコンのような半導体単結晶や、ガリウム砒素などの化合物半導体）を成長させる半導体単結晶製造装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来から、半導体素子の基板には、主として高純度の単結晶シリコンのような半導体単結晶やガリウム砒素などの化合物半導体が用いられているが、この半導体の製造方法の一つとして、ルツボ内の原料融液から円柱状のインゴットを引き上げるCZ法（チョクラルスキー法）が知られている。

【0003】

このCZ法は、まず、半導体インゴット製造装置のチャンバ内に設置したルツボに原料である素材を充填し、そのルツボの周囲に設けたヒータによって原料を加熱溶解させる。そして、シードホルダに取り付けた種結晶を融液に着液させ、シードホルダ及びルツボを互いに同方向または逆方向に回転しつつシードホルダを引き上げて、所定の大きさの円柱状のインゴットを成長させる。その後、このインゴットを薄くスライスすることで半導体集積回路等に使用するシリコンウェハを製作する（例えば、特許文献1参照）。

【0004】

図6は、このようなCZ法による半導体インゴット製造装置を示している。図6（A）はシードホルダに取り付けた種結晶を融液に着液している状態の説明図、図6（B）はシードホルダを引き上げてインゴットを成長させた状態の説明図である。

【0005】

図6において、半導体インゴット製造装置1は、有底円筒形状のチャンバ2と、このチャンバ2の上部中央から立ち上がる筒状のプルチャンバ3とを備えている。

チャンバ2の炉内には、上方に開放する有底円筒形状の石英よりなるルツボ4と、このルツボ4の底面に上端が固定された回転軸7とを備える。回転軸7の下端は、チャンバ2の外において図示を略する駆動源に接続されており、チャンバ2内でルツボ4が回転できるように支持している。ルツボ4の周りにはルツボ4を囲繞するヒータ5を設け、さらに、ヒータ5の周囲には外周を包囲してヒータ5からの輻射熱がチャンバ2の内壁に直接輻射されることを防止する断熱材6を設けている。

【0006】

プルチャンバ3の上部には、ワイヤー9の巻取器10を設けている。このワイヤー9の先端には、連結部材11を介してシードホルダ12が装着されている。連結部材11には、チャージ及びリチャージ工程の際には原料となる素材を補充するためのホッパー（図示せず）が吊り下げられ、インゴット13の引上げ工程の際には種結晶を装着したシードホルダ12が吊り下げられる。また、プルチャンバ3の下方寄りには、プルチャンバ3内を上下で隔絶するためのゲートバルブ14が設けられている。

【0007】

このような構成において、チャンバ2内に設置したルツボ4に原料である素材を充填した後、そのルツボ4の周囲に設けたヒータ5の輻射熱によって素材を加熱溶解してシリコン融液8とする。その後、シードホルダ12に取り付けた種結晶をシリコン融液8に着液させ、シードホルダ12及びルツボ4を互いに同方向または逆方向に回転しつつ巻取器10を駆動させることにより、シードホルダ12を引き上げてインゴット13を成長させる。

。

【特許文献1】特開平8-261903号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

一般にインゴットの引上げに用いられるワイヤー9は、種結晶ならびにインゴット13の回転振れや耐熱等を考慮し、主にタングステンが用いられていることが多い。このタングstenは、空気との反応においては400℃位になると酸化が始まる。また、タングstenは、700℃になると高級酸化物 WO_3 を形成して急激に酸化する性質を有する。

【0009】

一方、半導体インゴット引き上げの雰囲気は、殆どが不活性ガスである置換ガスによって大半を占められ、その他に、シリコン融液8と石英ルツボ4との反応によって生成される酸化物が微量に存在する。このように半導体インゴット引き上げの雰囲気は、空気に比べて酸素の量が絶対的に少ないため、400℃程度の温度ではタングstenワイヤー9には殆ど酸化は起こらない。

【0010】

しかしながら、タングstenワイヤー9が700℃以上の高温下に晒されると、シリコン融液8からの酸化物がワイヤー9の表面にて急激に反応し、タングstenの酸化物が形成される。

【0011】

上記の如く構成された半導体インゴット製造装置にあっては、シリコン融液8内に種結晶を着液させている状態、すなわち図6(A)に示した状態にあるときには、チャンバ2の炉内はその容積等に応じて異なるものの、例えば、ルツボ4の直上付近のエリアAでは約900℃～1000℃、その上方のエリアBでは約700℃～900℃、さらにその上方のエリアCでは約700℃未満といったように、複数段階の温度差の雰囲気下にある。

【0012】

特に、ワイヤー9の連結部材11付近の炉内露出部分は、約1000℃前後の比較的高温な雰囲気下に晒され易く、ヒータ5からの輻射熱やシリコン融液8からの酸化物との反応により表面が酸化し易い。その結果、ワイヤー9に局所的な機械的強度の劣化が存在することになり、ワイヤー9の大部分における機械的強度が十分であるにもかかわらず、ワイヤー全体の交換を余儀なくされてしまうという問題が生じていた。

【0013】

本出願に係る発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、チャンバの炉内高温雰囲気下におけるワイヤーの局所的な劣化を低減することができる半導体単結晶製造装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0014】

上記目的を達成するため、本出願に係る第1の発明は、炉内に融液が充填されるルツボを設けたチャンバと、該ルツボを加熱するヒータと、前記チャンバ内に設けられたワイヤーとを備えた半導体単結晶製造装置において、前記ワイヤーの少なくとも高温にさらされる領域を、カラーで覆ったことを特徴とする半導体単結晶製造装置である。

【0015】

また、本出願に係る第2の発明は、前記カラーを複数に設けたことを特徴とする上記第1の発明に記載の半導体単結晶製造装置である。

【0016】

さらに、本出願に係る第3の発明は、前記カラーはワイヤー巻き上げ装置と種結晶との間に設けられていることを特徴とする上記第1又は第2の発明に記載の半導体単結晶製造装置である。

【0017】

また、本出願に係る第4の発明は、前記カラーを前記ワイヤーを覆うよう近接させて設けたことを特徴とする上記第1～3の発明の何れか1つに記載の半導体単結晶製造装置である。

【0018】

さらに、本出願に係る第5の発明は、炉内に融液が充填されるルツボを設けたチャンバと該チャンバの上方に配置されたプルチャンバと、該プルチャンバの内部と前記チャンバ

との間で昇降するシードホルダと、該シードホルダを連結部材を介して吊持するワイヤーとを備えた半導体単結晶製造装置において、前記シードホルダ若しくは前記連結部材の少なくとも一方の長さを、前記シードホルダに種結晶を取り付け、該種結晶が融液に着液する位置にあるとき、前記ワイヤーの先端近傍の露出部分が前記炉内の高温雰囲気下で所定温度未満の範囲に位置する長さとしたことを特徴とする半導体単結晶製造装置である。

【0019】

また、本出願に係る第6の発明は、前記所定温度未満とは700℃未満であることを特徴とする上記第5の発明に記載の半導体単結晶製造装置である。

【発明の効果】

【0020】

本発明の半導体単結晶製造装置にあつては、炉内に融液が充填されるルツボを設けたチャンバと、ルツボを加熱するヒータと、チャンバ内に設けられたワイヤーとを備え、前記ワイヤーの少なくとも高温にさらされる領域をカラーで覆っているため、ワイヤーへの直接の輻射熱や酸化物との反応が防止され、ワイヤーの局所的な劣化を低減することができる。

【0021】

さらに、本発明の半導体単結晶製造装置にあつては、カラーを複数に設けたことにより、カラーの製作において加工精度が確保され、かつ、引き上げ時の熱的影響による変形がワイヤーの本来持っている結晶回転時の偏芯精度に影響するのを抑えることができる。また、温度域によるワイヤー露出位置の調節が可能となり、ワイヤー酸化速度の制御が可能となる。

【0022】

また、本発明の半導体単結晶製造装置にあつては、シードホルダ若しくは連結部材の少なくとも一方の長さを、シードホルダに取り付けられた種結晶が融液に着液する位置にあるときに、ワイヤーの先端近傍の露出部分が炉内の高温雰囲気下で所定温度未満の範囲に位置する長さとしていることにより、シードホルダが着液位置にあるときであってもワイヤー露出部分がチャンバの炉内高温雰囲気下を避けた位置にあるため、ワイヤーの局所的な劣化を低減することができる。

【0023】

このように本発明によれば、シードホルダが着液位置にあるときにワイヤーの先端近傍の露出部分が炉内の高温雰囲気下で所定温度以下を保った状態で、単結晶シリコンを成長させることにより、耐久性の高い半導体単結晶製造装置を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

次に、本発明の半導体単結晶製造装置を図面に基づいて説明する。

【実施例1】

【0025】

図1乃至図3は、本発明の半導体インゴット製造装置の実施例1を示し、図1(A)はシードホルダが着液位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、図1(B)はシードホルダが上端位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、図2(A)はワイヤーの断面図、図2(B)はワイヤー本体とカラーとの関係を示す要部の拡大断面図、図3はワイヤー本体を連結部材との関係を示す要部の拡大断面図である。

【0026】

図1において、半導体インゴット製造装置21は、有底円筒形状のチャンバ22と、このチャンバ22の上部中央から立ち上がる筒状のプルチャンバ23とを備えている。

チャンバ22の炉内には、上方に開放する有底円筒形状の石英よりなるルツボ24と、このルツボ24の底面に上端が固定された回転軸27とを備える。回転軸27の下端は、チャンバ22の外において図示を略する駆動源に接続されており、チャンバ22内でルツボ24が回転できるように支持している。ルツボ24の周りにはルツボ24を囲繞するヒータ25を設け、さらに、ヒータ25の周囲には外周を包囲してヒータ25からの輻射熱

がチャンバ22の内壁に直接輻射されることを防止する断熱材26を設けている。

【0027】

一方、プルチャンバ23の上部には、ワイヤー29の巻取器30を設けている。このワイヤー29の先端には、連結部材31を介してシードホルダ32が装着されている。連結部材31には、チャージ及びリチャージ工程の際には原料となる素材を補充するためのホッパー（図示せず）が吊り下げられ、インゴット33の引上げ工程の際には種結晶を装着したシードホルダ32が吊り下げられる。

【0028】

また、プルチャンバ23の下方寄りには、プルチャンバ23内を上下で隔絶するためのゲートバルブ34を設けている。プルチャンバ23内とチャンバ22内は連続した気密空間を形成しているが、インゴット33の引上げ最中以外にはゲートバルブ34を閉めることによりチャンバ22内では融液を維持し、その状態でプルチャンバ23内にガスを封入する事により大気開放を可能とし、引上げられたインゴット33の取り出しやホッパー並びに種結晶の取り付け等を可能としている。

【0029】

巻取器30は、ワイヤー50の先端に装着されたシードホルダ32を着液位置（図1（A）に示す位置）と上端位置（図1（B）に示す位置）との間で昇降させる。着液位置は、シードホルダ32の先端に備えた種結晶がシリコン融液28の液面に着いたときの位置であり、上端位置は、成長したインゴット33を引き上げきった位置である。

【0030】

ワイヤー50は、ワイヤー本体51と、このワイヤー本体51に設けられた複数のカラー52とを備えている。ワイヤー本体51には、種結晶ならびにインゴット13の回転振れや耐熱等を考慮し、タングステンなどの材料からなる線材を振り込んだもの（ストランド）が使用されている。

【0031】

また、図2に示すようにワイヤー本体51の両端には、ボールジョイント方式の嵌め合いにより巻取器30並びに連結部材31と連結される連結部53、54がそれぞれ設けられている。これにより、例えば、連結部材31には、図3に示すように、連結部54が嵌め合わされる際の挿入部31aが形成されている。

【0032】

連結部54はステンレス製のかしめ部54aをかしめることによりワイヤー本体51に取り付けられている。連結部材31にはかしめ部54aのみが接触し、ワイヤー本体51は連結部材31には直接接触しないため、ワイヤー本体51の磨耗を防ぐことができる。また、連結部材31内にワイヤー本体51が露出されることがないため、挿入部31aから連結部材31内に侵入する雰囲気ガスにワイヤー本体51が晒されることもなく、ワイヤー本体の酸化消耗を防止し、ワイヤーの劣化を低減させることができる。

【0033】

カラー52は、ステンレスやモリブデン、タングステン等により円筒形状に形成されており、図2（B）に示すように、その両端には隣接する上下で互いに隙無く連結するための雌雄の異なる係合部としての凸部52aと凹部52bとが形成されている。このように、複数の分割されたカラーに雌雄の異なる係合部を設けることにより、互いに上下方向で隣接するもの同士の隙間の発生を防止することができ、カラーの隙間からの輻射熱や酸化物の侵入を防止することができる。

【0034】

また、カラー52は、ワイヤー本体51の直径dに対して内径Dの方が大径とされている。この際、内径Dと直径dとの差は、ワイヤー本体51の経年的劣化により、その芯材（図示せず）が切断されたり線材の振りが戻った場合のように、部分的にワイヤー本体51の直径が膨らむことを許容している。

【0035】

このように、カラーの内径をワイヤーの直径よりも大径としたことにより、芯のあるワ

ワイヤーの場合に、側面のワイヤーに外傷がなくても芯のワイヤーが破断に近い状態にある時には側面のワイヤーの直径がカラー内径の範囲内で大きくなり、カラーを上下に動かすことにより、その摩擦力によりふくらみを検出でき、ワイヤー破断までに至るのを防止できる。

【0036】

例えば、定期的な点検時やホッパーと種結晶との交換時において、カラー52をワイヤー本体51の軸線に沿って移動させ、ワイヤー本体51に膨らみが発生していない場合にはカラー52の移動が滑らかに行われ、ワイヤー本体51に膨らみが発生している場合にはカラー52の移動が阻害されるため、ワイヤー本体51の劣化を容易に確認することができる。もちろん、カラー52が上下動可能なことにより、ワイヤー本体51の断線や変形を目視により確認できることは言うまでもない。

【0037】

また、引き上げるインゴット33の結晶長が長くなってもカラーが障害とならないように、カラー52の外径寸法は、巻き上げ部の空間を通過することができるサイズであることが好ましい。

【0038】

このような構成において、原料となる素材を内部に装填したホッパーを装着した状態でワイヤー50を下降させてルツボ24内に素材を落下投入する。素材の投入後ホッパーを上昇させて、一旦ゲートバルブ34によりプルチャンバ23を上下で隔絶する（実質的にはチャンバ22の炉内とプルチャンバ23の内部とを隔絶する）。その状態でプルチャンバ23内にガスを封入する事により大気開放を可能とし、ホッパーを連結部材31から取り外した後に、新たに種結晶を装着したシードホルダ32を連結部材31に装着する。

【0039】

その後、ゲートバルブ34を開放して種結晶をルツボ24のシリコン融液28の液面に接触させ、ルツボ24を回転させつつ（ワイヤー50を同時に同方向または逆方向に回転させても良い）ワイヤー50を巻取器30で巻き取ってシードホルダ32を引き上げることで単結晶のインゴット33が成長する。

【0040】

この際、図1(A)に示すようにシードホルダ32が着液位置にある状態では、ワイヤー本体51の先端部分はある程度の範囲でカラー52により覆われていることにより、ヒータ24からの輻射熱やシリコン融液28からの酸化物との反応によるワイヤー50の局所的な劣化を低減することができる。より具体的には、着液位置にあるときにカラー52により覆われているワイヤー本体51の先端が700℃未満になるようにする。

【0041】

また、シードホルダ32が着液位置にある状態において、ワイヤー本体51がカラー52から露出している部分、特に、カラー52の近部でカラー52から露出している部分が、炉内温度700℃前後のエリアBとエリアCとの境界付近からエリアC内に位置するように、カラー52の長さを調節する。より具体的には、着液位置にあるときにワイヤー本体51の露出部分が700℃未満になるように、カラー52の長さを設定する。

【0042】

このように、カラー52により覆うワイヤー本体51の範囲を、チャンバ22の炉内高さを考慮したうえでその高温雰囲気下に相当する範囲とすることにより、装置本体の設計変更をすることなく既存の連結部材31並びにシードホルダ32を使用したままワイヤー本体51の酸化に伴う劣化を低減することができる。

【0043】

特に、酸化物との反応が激しく始まる温度である700℃未満にワイヤーを保つことにより、ワイヤーの酸化を遅らせ、ワイヤーの局所的な劣化を低減することができる。

【0044】

上記の実施例ではインゴットの引き上げに用いられるワイヤーについて説明を行ったが、同じようにチャンバ内で用いられるワイヤーであれば、本発明のカラーの概念は同様に

して適用可能であり、本発明はインゴットの引上げに限ったものではない。

【実施例 2】

【0045】

図 4 は、本発明の半導体インゴット製造装置の実施例 2 を示し、(A) はシードホルダが着液位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、(B) はシードホルダが上端位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図である。

【0046】

尚、この図 4 に示した実施例 2 の半導体インゴット製造装置 21 は、上述した実施例 1 とはワイヤーの先端に設けられた連結部材とこの連結部材に装着されたシードホルダとが異なるのみなので、その他の構成部材には上記実施例 1 の図 1 と同一の符号を付してその説明を省略する。

【0047】

シードホルダ 32 はカーボン等から形成されており、着液位置にあるときにワイヤー 29 の先端近傍の露出部分がチャンバ 22 の炉内上方、即ち、少なくとも炉内高温雰囲気下でエリア B とエリア C との境界付近からエリア C 内に位置するように長さが設定されている。より具体的には、着液位置にあるときにワイヤー 29 の先端近傍のワイヤー露出部分が 700℃未満になるように長さを設定する。

【0048】

また、リチャージ引上げの場合、シードホルダ 32 の長さの最長は、インゴット 33 を吊り上げた上端位置にあるときに、そのインゴット 33 の下端がゲートバルブ 34 よりも上方に位置するように設定されている。この際、プルチャンバ 23 の設計変更（高さ変更やシール部品 35 並びに回転伝達部品 36 の大径化）は無いようにすることが好ましい。

【0049】

このような構成において、原料となる素材を内部に装填したホッパーを装着した状態でワイヤー 29 を下降させてルツボ 24 内に素材を落下投入する。素材の投入後ホッパーを上昇させて、一旦ゲートバルブ 34 によりプルチャンバ 23 を上下で隔絶する。ホッパーを連結部材 31 から取り外した後に、新たに種結晶を装着したシードホルダ 32 を連結部材 31 に装着する。

【0050】

ルツボ 24 内の素材をヒータ 25 により熔融させ、ゲートバルブ 34 を開放し、ワイヤー 29 を着液位置まで下降させて種結晶をルツボ 24 のシリコン融液 28 の液面に接触させる。ルツボ 24 を回転させつつ（ワイヤー 29 を同時に同方向または逆方向に回転させても良い）ワイヤー 29 を巻取器 30 で巻き取ってシードホルダ 32 を引き上げることで、単結晶のインゴット 33 が成長する。

【0051】

この際図 4 (A) に示すように、シードホルダ 32 が着液位置にある状態では、ワイヤー 29 の先端近傍のワイヤー露出部分、即ち、連結部材 31 の近部で連結部材 31 から露出している部分は、炉内温度 700℃前後のエリア B とエリア C との境界付近からエリア C 内に位置しているため、ヒータ 25 からの輻射熱やシリコン融液 28 からの酸化物との反応によるワイヤー 29 の局所的な劣化を低減することができる。

【0052】

特に、タングステンにおいて酸化物との反応が激しく始まる温度である 700℃未満の雰囲気、ワイヤー先端の露出部分を位置させることにより、ワイヤーの酸化を遅らせ、ワイヤーの局所的な劣化を低減することができる。

【実施例 3】

【0053】

図 5 は、本発明の半導体インゴット製造装置の実施例 3 を示し、(A) はシードホルダが着液位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、(B) はシードホルダが上端位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図である。

【0054】

尚、この図5に示した実施例3の半導体インゴット製造装置21は、上述した実施例1とはワイヤー29の先端に設けられた連結部材とこの連結部材に装着されたシードホルダとが異なるのみなので、その他の構成部材には上記実施例1の図1と同一の符号を付してその説明を省略する。

【0055】

連結部材41は、ワイヤー29に着脱可能に設けられていると共にシードホルダ42を着脱可能に保持している。また、連結部材41は、シードホルダ42が着液位置にあるときにワイヤー29の先端がチャンバ22の炉内上方、即ち、少なくとも炉内高温雰囲気下でエリアBとエリアCとの境界付近からエリアC内に位置するように長さが設定されている。より具体的には、着液位置にあるときにワイヤー29の先端近傍のワイヤー露出部分が700℃未満になるように長さを設定する。

【0056】

また、連結部材41の長さの最長は、インゴット33を吊り上げた上端位置にあるときに、そのインゴット33の下端がゲートバルブ34よりも上方に位置するように設定されている。この際、プルチャンバ23の設計変更（高さ変更やシール部品35並びに回転伝達部品36の大径化）は無いようにすることが好ましい。

【0057】

このような構成においても、ゲートバルブ34を開放して種結晶をルツボ24のシリコン融液28の液面に接触させ、ルツボ24を回転させつつ（ワイヤー29を同時に同方向または逆方向に回転させても良い）ワイヤー29を巻取器30で巻き取ってシードホルダ42を引き上げることで、単結晶のインゴット33が成長する。

【0058】

この際図5（A）に示すように、シードホルダ42が着液位置にある状態では、ワイヤー29の先端近傍のワイヤー露出部分、即ち、連結部材41の近部で連結部材41から露出している部分は、炉内温度700℃前後のエリアBとエリアCとの境界付近からエリアC内に位置しているため、ヒータ25からの輻射熱やシリコン融液28からの酸化物との反応によるワイヤー29の局所的な劣化を低減することができる。

【0059】

特に、タンゲステンにおいて酸化物との反応が激しく始まる温度である700℃未満の雰囲気、ワイヤー先端の露出部分を位置させることにより、ワイヤーの酸化を遅らせ、ワイヤーの局所的な劣化を低減することができる。

【0060】

尚、上記の実施例2または3においては、上記実施例1に開示した構成を併用しても良い。また、上記実施例1乃至3において、ワイヤーとシードホルダを結合するために連結部材を用いているが、本願において連結部材とは、必ずしもシードホルダと別部材である必要はなく、シードホルダの一部でワイヤーとの結合の役割を果たす部位も含む。

【産業上の利用可能性】

【0061】

ワイヤーの高温に晒される領域にカラーを設けることは、上記の実施例1に示したインゴットの引き上げに用いられるワイヤーに限定されるものではなく、炉内に配置される如何なる目的のワイヤーに対しても適用することができる。

また、上記の実施例1乃至3の説明においては、単結晶インゴットの製造を例に説明しているが、本発明は単結晶インゴット以外にも化合物半導体のインゴットやその他のインゴットについても適用可能である。

【図面の簡単な説明】

【0062】

【図1】本発明の半導体インゴット製造装置の実施例1を示し、（A）はシードホルダが着液位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、（B）はシードホルダが上端位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図である。

【図2】本発明の半導体インゴット製造装置の実施例1を示し、（A）はワイヤーの

断面図、(B)はワイヤー本体とカラーとの関係を示す要部の拡大断面図である。

【図3】本発明の半導体インゴット製造装置の実施例1を示し、ワイヤー本体を連結部材との関係を示す要部の拡大断面図である。

【図4】本発明の半導体インゴット製造装置の実施例2を示し、(A)はシードホルダが着液位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、(B)はシードホルダが上端位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図である。

【図5】本発明の半導体インゴット製造装置の実施例3を示し、(A)はシードホルダが着液位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、(B)はシードホルダが上端位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図である。

【図6】半導体インゴット製造装置の従来例を示し、(A)はシードホルダが着液位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図、(B)はシードホルダが上端位置にある状態の半導体インゴット製造装置の説明図である。

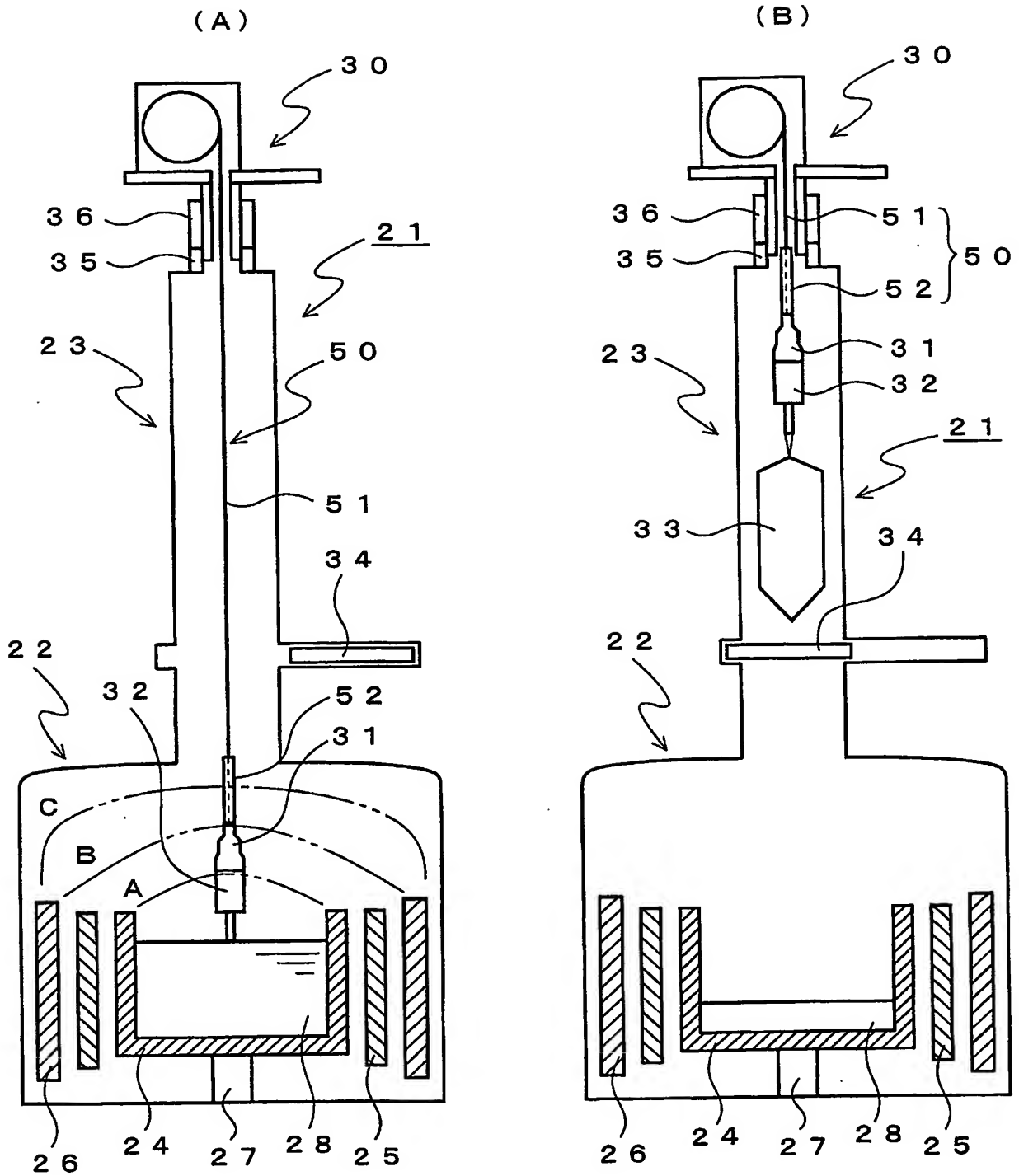
【符号の説明】

【0063】

- 1…半導体インゴット製造装置
- 2…チャンバ
- 3…プルチャンバ
- 4…ルツボ
- 5…ヒータ
- 6…断熱材
- 7…回転軸
- 8…シリコン融液
- 9…ワイヤー
- 10…巻取器
- 11…連結部材
- 12…シードホルダ
- 13…インゴット
- 14…ゲートバルブ
- 21…半導体インゴット製造装置
- 22…チャンバ
- 23…プルチャンバ
- 24…ルツボ
- 25…ヒータ
- 26…断熱材
- 27…回転軸
- 28…シリコン融液
- 29…ワイヤー
- 30…巻取器
- 31…連結部材 31a…挿入部
- 32…シードホルダ
- 33…インゴット
- 34…ゲートバルブ
- 35…シール部品
- 36…回転伝達部品
- 41…連結部材
- 42…シードホルダ
- 50…ワイヤー
- 51…ワイヤー本体
- 52…カラー 52a…凸部 52b…凹部
- 53…連結部

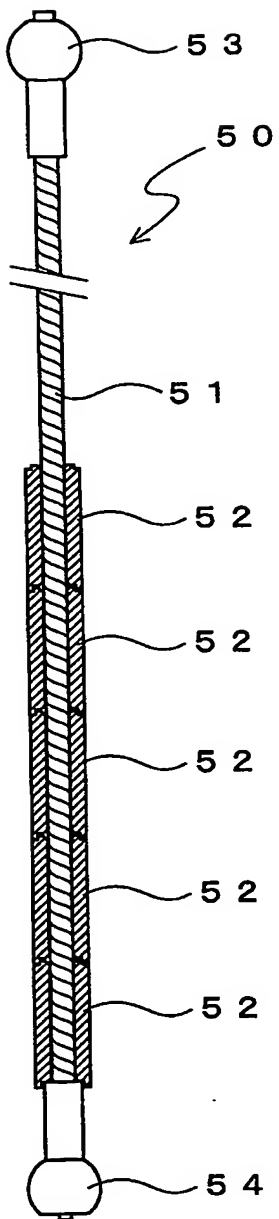
5 4 …連結部 5 4 a …かしめ部。

【書類名】 図面
【図1】

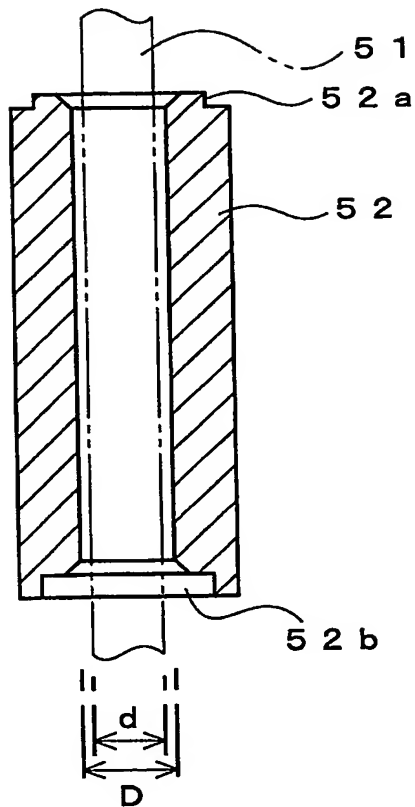


【図 2】

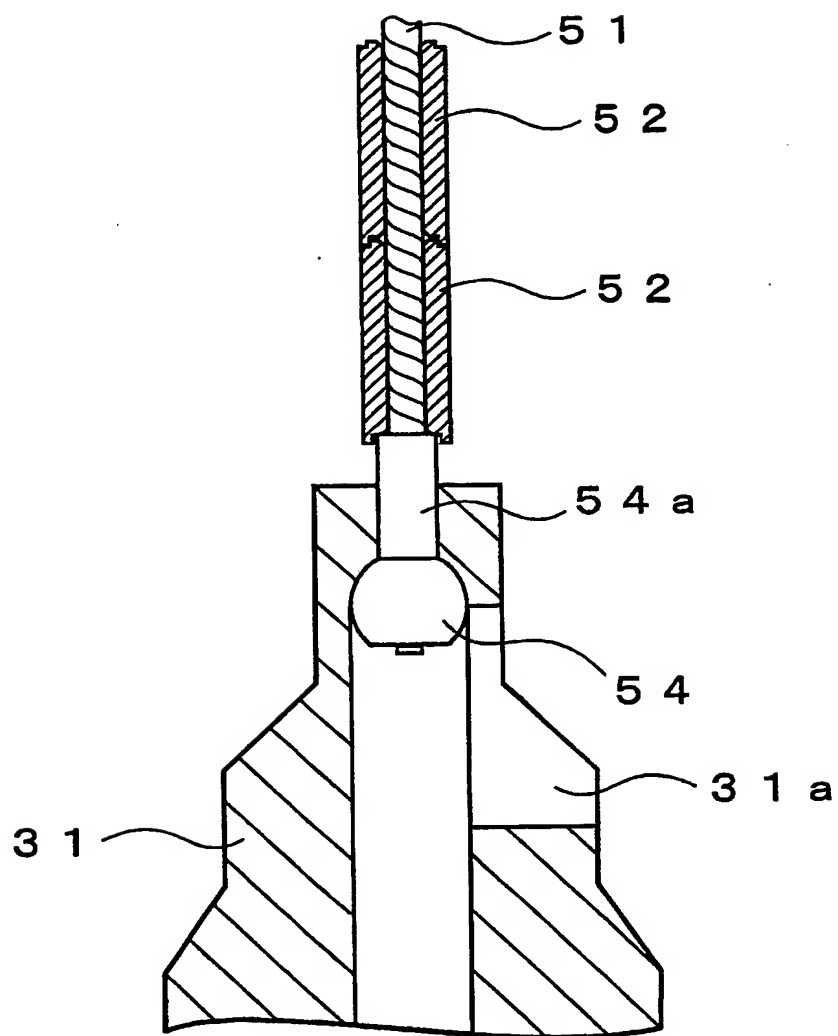
(A)



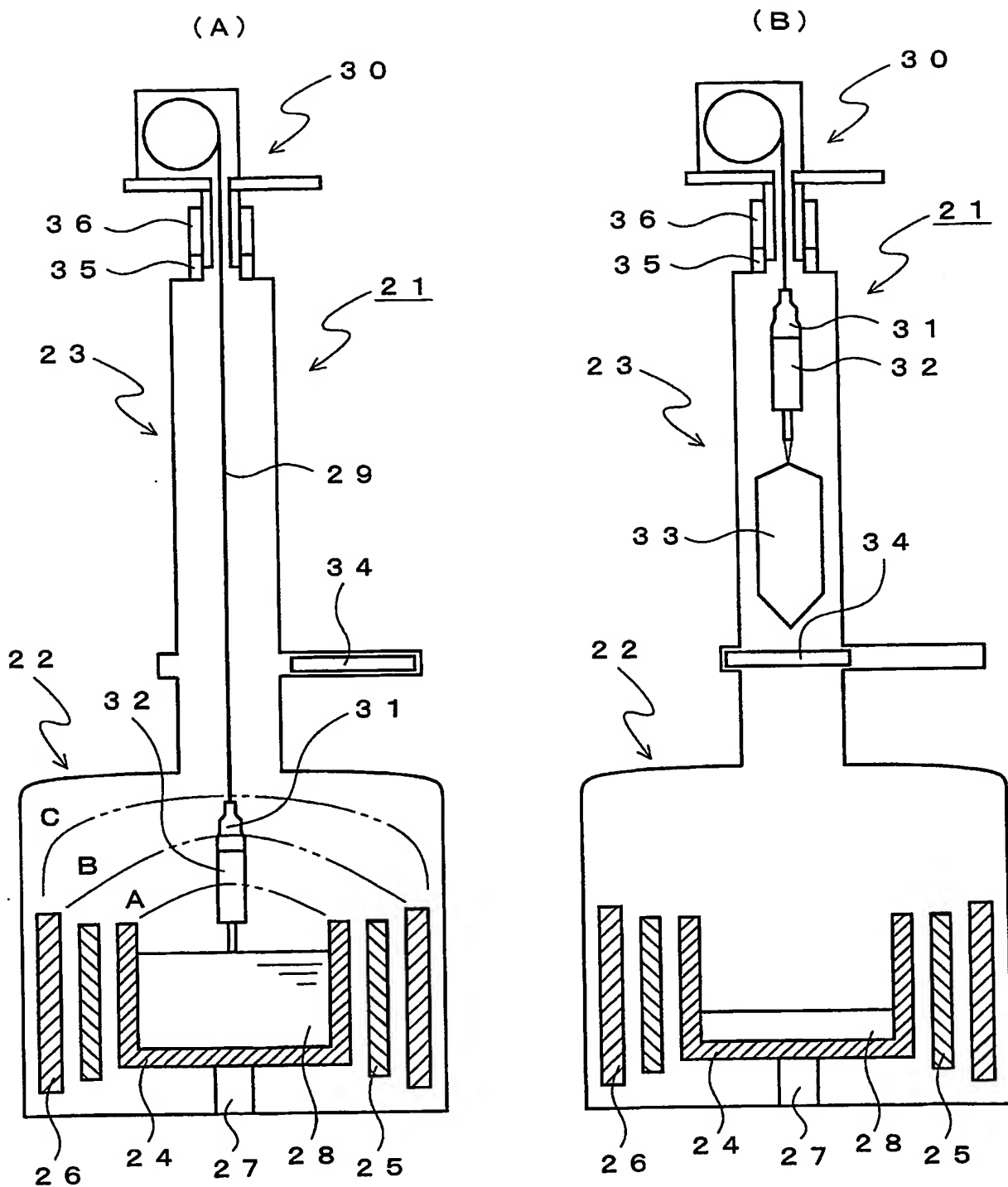
(B)



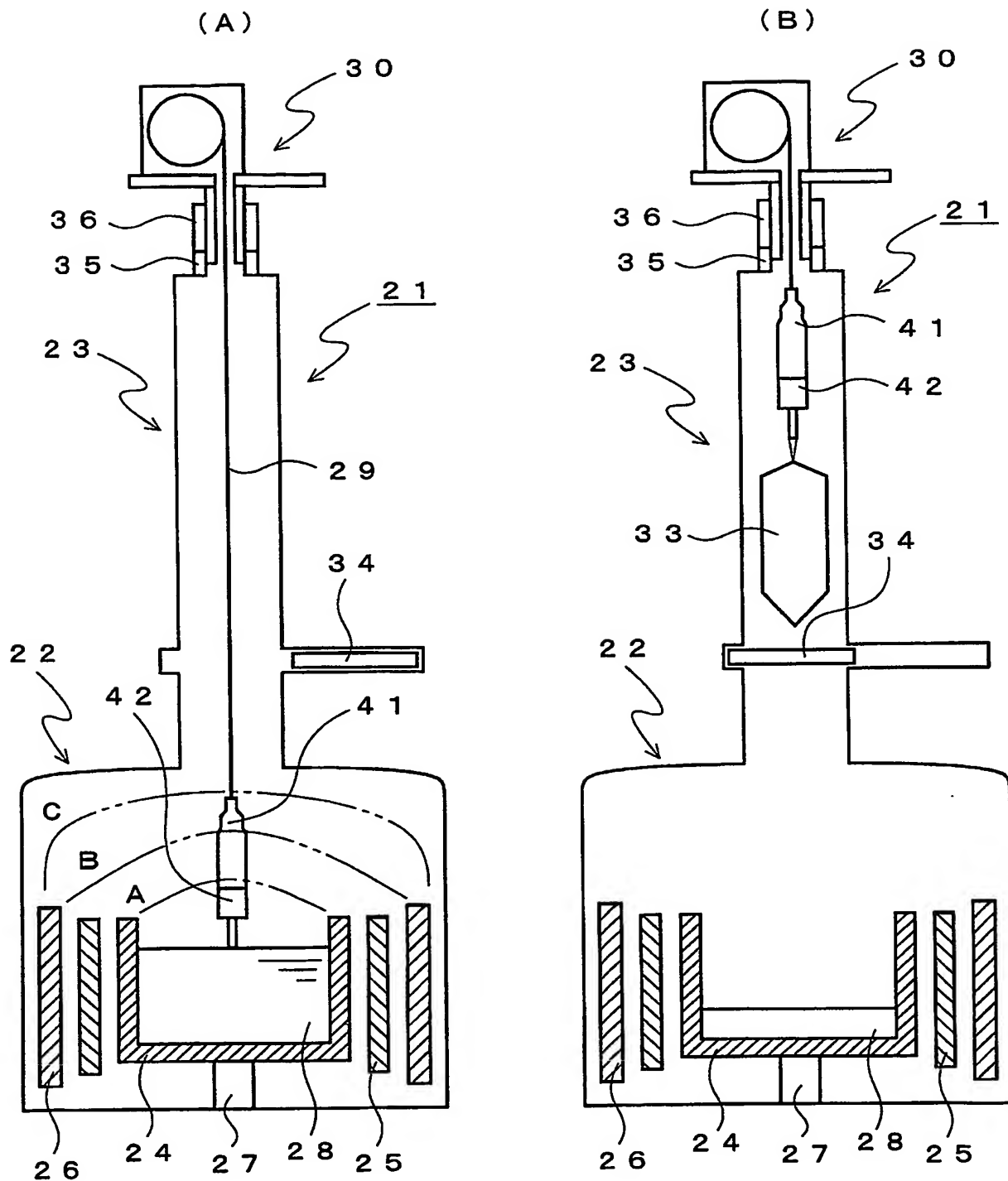
【図 3】



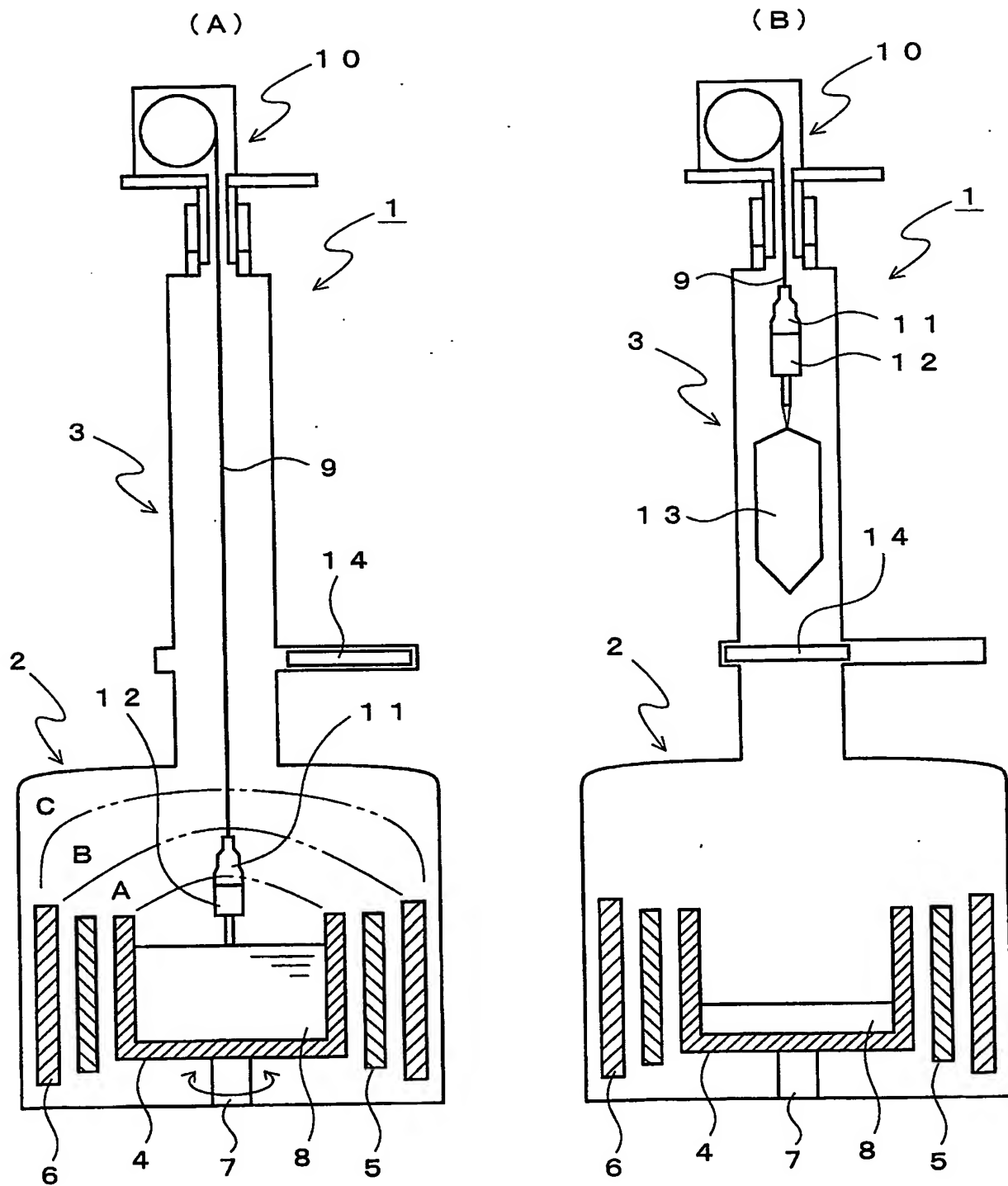
【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 チャンバの炉内高温雰囲気下によるワイヤーの局所的な劣化を低減することができる半導体単結晶製造装置を提供する。

【解決手段】 チャンバ 22 の炉内にシリコン融液 28 が充填されるルツボ 24 が設けられ、チャンバ 22 の上方にプルチャンバ 23 が配置され、プルチャンバ 23 の内部と炉内との間で昇降されるシードホルダ 32 が連結部材 31 を介してワイヤー 50 に吊持されると共に、シードホルダ 32 が着液位置にあるときにワイヤー 50 の先端近傍のワイヤー露出部分が炉内の高温雰囲気下で所定温度以下になるように、ワイヤー 50 にカラー 52 を設ける。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-353962
受付番号	50301705561
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成15年10月15日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年10月14日
-------	-------------

特願 2 0 0 3 - 3 5 3 9 6 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 8 4 7 1 3]

1. 変更年月日

2 0 0 1 年 2 月 1 5 日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県平塚市四之宮 3 丁目 2 5 番 1 号

氏 名

コマツ電子金属株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.